TOKAI CARBON KOREA

Investor Relations



Disclaimer

All information regarding management performance and financial results of Tokai Carbon Korea (the “Company”) during the end of 2026.3Q as contained herein has been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRS”).

When referring to this material, please check with the IR representative before using it.

The information contained herein should not be utilized for any legal purposes in regard to investors’ investment results. The Company hereby expressly disclaims any and all liability for any loss or damage resulting from the investors’ reliance on the information contained herein.

Contents

01. Company Overview

02. Business Overview

03. Growth Strategy

04. Business Performance

05. Appendix



01.

Company Overview

01. 회사개요

반도체 공정용 Solid-SiC Parts 영역의 Global No.1

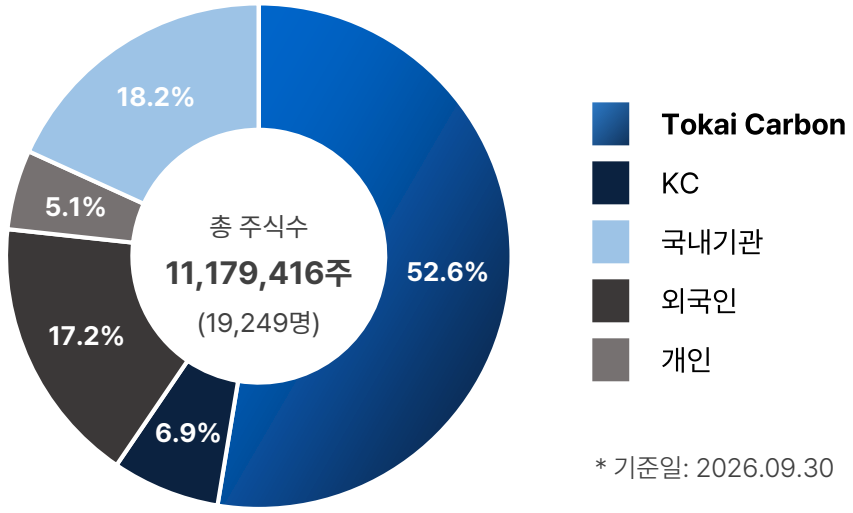
At a Glance

Global No.1	M/S 80%+	CAGR 20%+	OPM 28%+
Solid-SiC 부품시장 지위	Solid-SiC OEM 시장 점유율	2013~2026년 평균 매출성장률	2026년 3분기 누적 영업이익률

회사현황

회사명	티씨케이(Tokai Carbon Korea)
대표이사	카나이 켄이치, 오창민
설립일	1996년 08월 07일
매출액	3,004억 원 (2026.09.30 누계)
자본금	58.4억 원 (2026.09.30)
자산총계	6,290억 원 (2026.09.30)
임직원	522명 (2026.09.30)
소재지	본사: 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 사무소: 경기도 성남시 대왕판교로 670

주주현황

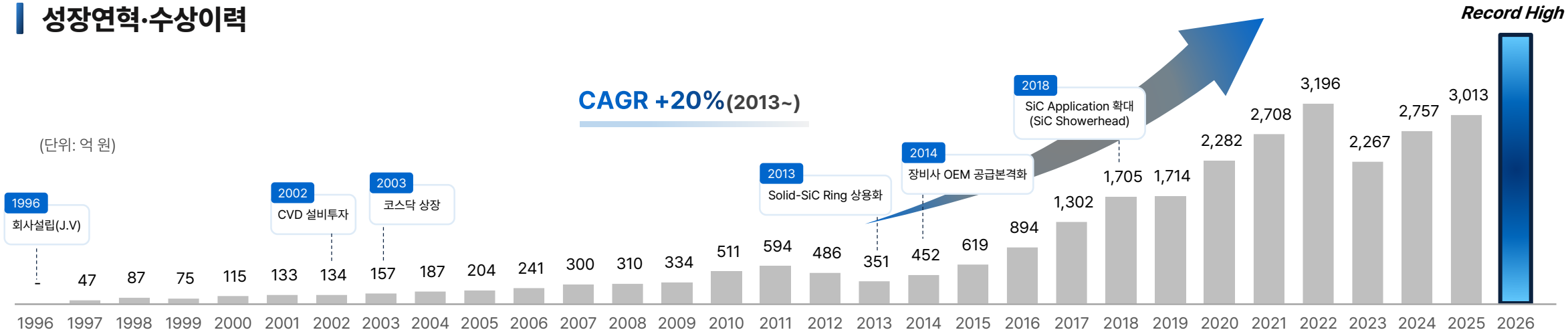


* 기준일: 2026.09.30

02. 회사연혁

지속적인 매출성장과 글로벌 고객의 신뢰로 입증해 온 30년의 성장 궤적

성장연혁·수상이력





2020.12 | Applied Materials

Excellence in Aftermarket Support



2024.09 | Lam Research

New Product Introduction Performance Award



2025.11 | Tokyo Electron

Excellent Achievement Award



2026.03 | AMEC(China)

Excellent Quality Performance



2026.05 | 한국거래소(KRX)

기업가치제고 우수기업 금융위원장상 수상

02.

Business Overview

01. 사업영역

다각화된 제품 포트폴리오를 통해 반도체 웨이퍼 제조, 식각, 증착 등 핵심공정 대응

Wafering Process — *Front-End Process* — *Back-End Process*

웨이퍼 제조 → 산화 → 노광 → 식각 → 박막증착 → 금속배선 → EDS 테스트 → 패키징

Pure Graphite | 매출비중 7.1%

실리콘 잉곳 성장을 위한 고순도 흑연부품



Pure Graphite Hot Zone

고온 환경에서 안정적인 열적 특성을 제공하여
Silicon Ingot Growing 공정의 온도제어를 지원

Customer (In ABC Order)

Hana Materials / MEMC / OCI
SK Siltron / Silfex / Etc.

Solid-SiC | 매출비중 89.8%

고강도 Plasma 환경에 대응하는 고순도·고내구 부품

SiC Focus Ring



SiC Shower Head



Solid-SiC의 우수한 내플라즈마 특성을 통해
식각 공정의 가동시간 연장 및 공정 운영비용 절감을 지원

Customer (In ABC Order)

AMEC / Applied Materials
Lam Research / Samsung Electronics
SEMES / SK Hynix / Etc.

Susceptor | 매출비중 3.1%

고온 공정용(CVD, ALD, SiC Epi) 코팅 부품



SiC / TaC Coated Suceptor

초고순도 SiC / TaC 박막 코팅을 통해
고온의 증착공정에서 웨이퍼의 균일한 온도 분포를 지원

Customer (In ABC Order)

Jusung Enginerring / ST Micron
Tankeblue / Wonik IPS / Etc.

02. Solid SiC

Advanced Etch 공정 고도화에 대응하는 고내구성 Solid-SiC Solution

Solid-SiC Focus Ring(Edge Ring)



식각공정에서 Wafer Edge의 Plasma를
제어하여 식각 균일도를 유지하는 핵심 부품

01 *고순도·고내구 Solid-SiC*

Si / Quartz 소재 대비 우수한 내플라즈마성으로
식각공정 MTBC 개선 및 TCO 절감 기여

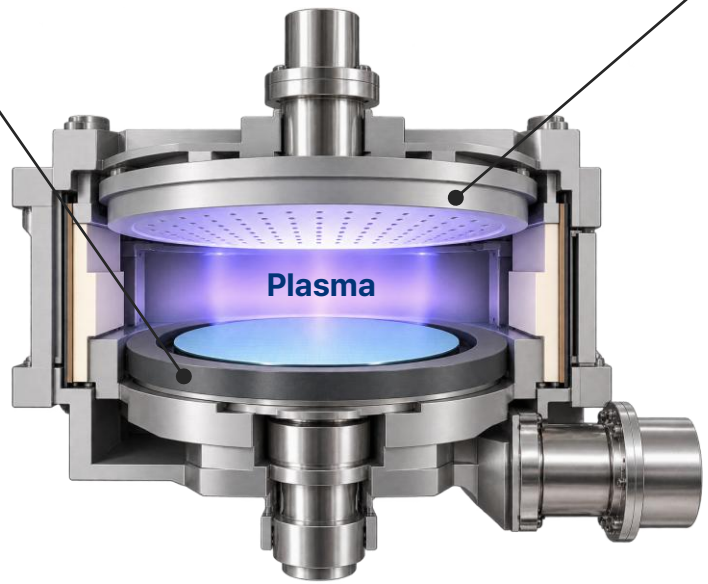
02 *고종횡비(HAR) 선단 식각공정 대응*

3D NAND Channel Hole, Slit, Contact
DRAM Capacitor Hole , TSV Hole 등

03 *반복 교체형 단수명 소모품*

지속적인 Plasma 노출에 의한 반복 교체 수요
지속 발생(공정에 따라 3~5주)

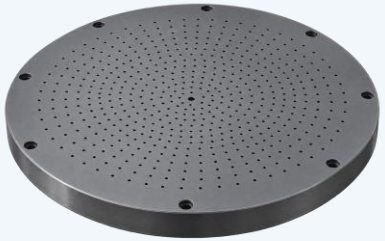
Etch Process Chamber



Major Customers

AMEC / Applied Materials / Lam Research
SEMES / Tokyo Electron / Etc. (In ABC Order)

Solid-SiC Shower Head(Upper Electrode)



식각 Process Gas를 분사하고
플라즈마 환경을 균일하게 형성·제어하는 핵심 부품

01 *고순도·고내구 Solid-SiC*

부식성 Process Gas 및 고에너지 Plasma에서도
고내구성으로 부품 열화 및 공정오염 리스크 저감

02 *선단 유전체(Dielectric) 식각공정 대응*

3D NAND 고종횡비(HAR) 구조 형성을 위한
고출력 Dielectric Etch 공정 핵심 부품

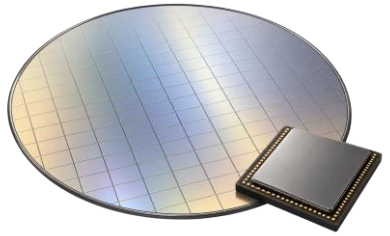
03 *반복 교체형 소모품*

지속적인 부식성 Gas 및 Plasma 노출에 의한
반복 교체 수요 지속 발생(공정에 따라 3~4개월)

03. Value Chain(Solid-SiC)

Before Market 중심의 시장구도에서 압도적인 점유율을 유지

Value Chain(Solid-SiC Market)

Solid-SiC Parts Supplier		Equipment Maker		Chip Maker
Before Market ✓ 신규 설치수요 ✓ 반복 교체수요 ✓ 선단 Node 중심	SiC 부품 공동개발·공급	 AMEC / Applied Materials / Lam Research SEMES / Tokyo Electron / Etc. (In ABC Order)	Service Contract Consumable SiC 부품 교체	 Kioxia / Micron / Samsung Electronics SK Hynix / YMTC / TSMC / Etc. (In ABC Ordrer)
After Market ✓ 반복 교체수요 ✓ 구세대 Node 중심				

Warrnty/Service Contract 종료 후 구세대 Node 직접 공급

Market Share

Total Market



Before Market



04. Driving Forces of Growth

3대 수요동인(신규투자, 전환투자, Fab가동률)에 의한 안정적인 Solid-SiC 수요 기반 확보

Capacity Expansion



- ✓ *신규Fab 건설 및 신규라인 투자*
- ✓ *식각장비 Set-up*
- ✓ *Fab Capacity 확대*

Tech Node Migration



- ✓ *선단공정으로의 전환투자*
- ✓ *소자 구조의 미세화·고단화*
- ✓ *고종횡비·고강도 식각공정 확대*

Utilization



- ✓ *Silicon Wafer 투입량 증가*
- ✓ *반도체 라인 설비가동률 증가*
- ✓ *(Memory)Bit Production 증가*

Installed Base



- ✓ *식각장비 부품 초도수요 발생*
- ✓ *식각장비 Installed Base 증가*
- ✓ *식각 부품 교체수요 기반 확대*

Etch Intensity



- ✓ *고단화에 따른 식각 Step 증가*
- ✓ *종횡비(AR) 증가로 고출력 Plasma 증가*
- ✓ *식각 부품 수요확대 및 스펙 강화*

Operating Hours



- ✓ *식각장비 가동시간 증가*
- ✓ *식각 Plasma 노출시간 증가*
- ✓ *소모성 부품의 반복 교체수요 발생*

05. 경쟁우위

4대 핵심 경쟁우위를 기반으로 Solid-SiC 부품 시장 Global No.1 지위를 공고히 유지



Technology Leadership

- ✓ *Solid-SiC Parts 세계최초 상용화*
- ✓ *강력한 제조 IP Porfolio 구축*
- ✓ *선단공정 대응을 위한 선행개발 지속*

Strategic Partership

- ✓ *글로벌 장비 고객과 강력한 파트너십*
- ✓ *신규공정 & 신규장비 Parts 공동개발*
- ✓ *차세대 공정환경에 대한 선제적 진입*

Manufacturing Excellence

- ✓ *업계 최대의 Solid-SiC 양산체제*
- ✓ *업계 최고 수준의 품질경쟁력*
- ✓ *최장기 Solid-SiC Track-Record*

Price Competitiveness

- ✓ *고순도 원재료 수직계열화(관계사)*
- ✓ *SiC 소재부터 완제품까지 통합생산*
- ✓ *우수한 양산성 기반 가격경쟁력*

03.

Growth Strategy

01. 성장전략

Solid-SiC 기술역량을 기반으로 Application 확대 및 차세대 소재 개발로 사업영역을 단계적 확대

Market Leadership

Solid-SiC Focus Ring
시장 선도



반도체 미세화·고단화 Trend에 따라
CVD-SiC Ring의 **구조적인 성장 지속**

Application Expansion

Solid-SiC
Application 확대



CVD-SiC 기술 역량을 활용한
Shower Head 등 다양한 핵심 반도체 부품
신규 Application 확대

Next-Gen Materials

차세대 영역 진출
단결정 SiC 소재 확장



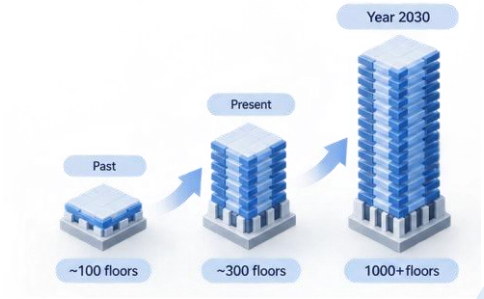
축적된 CVD-SiC 소재·공정 기반으로
단결정 SiC 등 **차세대 소재 영역 진출**

02. SiC Focus Ring 수요 확대 대응

NAND·DRAM·LOGIC 전반의 2D → 3D 구조변화가 CVD-SiC Ring 시장의 확대를 견인

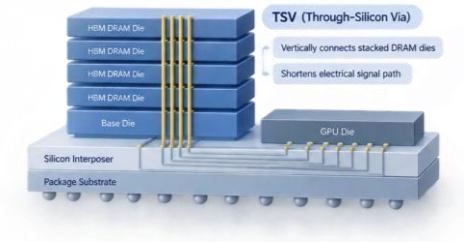
NAND Flash

- ✓ *저장용량 증가를 위한 적층 수 확대 (100+ → 300+ → 1,000+Layers)*
- ✓ *식각공정 고종횡비(HAR) 심화*
- ✓ *차세대 NAND 극저온 식각 적용*



HBM

- ✓ *대역폭 확대를 위한 TSV Hole 증가*
- ✓ *세대 전환에 따른 HBM 적층수 증가 (12단 → 16단 → 20단)*



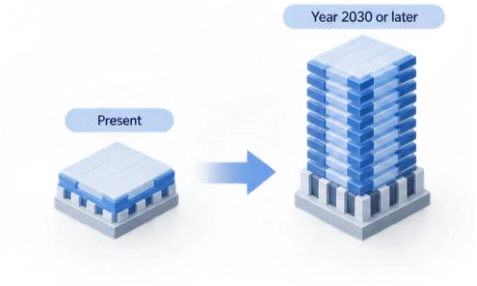
Mega Trend

3D Scaling

미세화·고단화

DRAM

- ✓ *2D DRAM 미세화 식각 난이도 증가*
- ✓ *미세화 한계에 따른 수직 구조 등장*
- ✓ *수직구조 심화로 3D-DRAM 등장*



Logic / Foundry

- ✓ *공정미세화를 위한 새로운 구조 등장 (GAA / CFET)*
- ✓ *공정 미세화 심화에 따라 수율향상을 위한 SiC RING 적용 확대 검토 중*



03. Solid-SiC Application 확장

Focus Ring – Shower Head에 이어 고사양 반도체 핵심 소재로서 Application을 확장 중

Silicon / Quartz
기존 공정환경

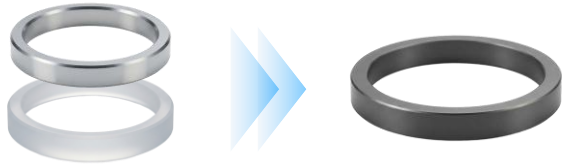
공정 미세화 & 3D Scaling에 따른 플라즈마 강도 증가

Silicon Carbide
차세대 공정환경



Focus Ring(Edge Ring)

2013년 SiC Focus Ring 최초 상용화 이후
*기존 **Si / Quartz 소재의 대체수요 지속 확대***



Shower Head(Upper Electrode)

2018년 SiC Shower Head 최초 상용화 이후
*중국 수요 지속 확대, **미국·일본 고객 테스트 진행***

Other Critical Process Parts

반도체 공정 환경이 지속적으로 가혹해짐에 따라,
다양한 반도체 핵심 부품에 Solid-SiC 적용 검토

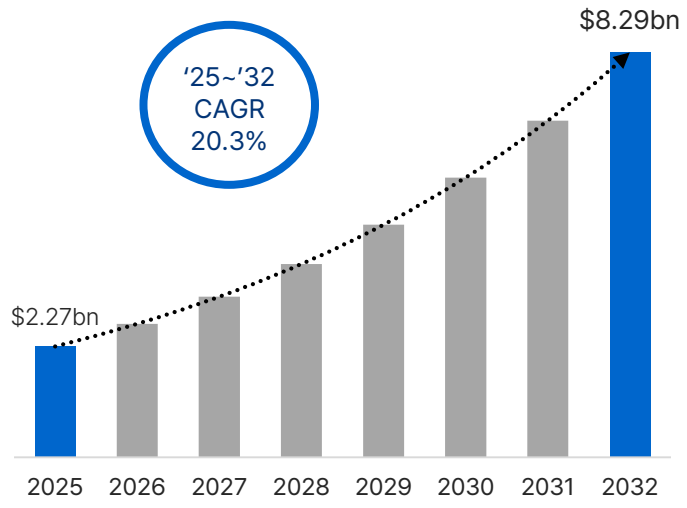


04. 차세대 소재 개발

PVT가 지배하는 시장의 차별화된 플레이어, 차세대 Game Changer를 지향

2025년	2027년	2028년	2029년
01	02	03	04
제품 성능검증	*2차 투자 집행*	*목표 잉곳 성장률 달성*	*고객 Qualification & 양산*

시장전망(SiC Wafer Market)



(Source: Persistence Market Research, 2025)

보유기술 : HT-CVD



티씨케이



기존 Player

- ✓ ***Proto Type: High-End 성능검증 완료****(3개 연구기관)*
- ✓ ***양산성 보완을 위한 2차 투자 집행 中***

보유기술 경쟁력

HT-CVD	PVT
우수한 경제성 (연속성장)	경제성 한계 (제한된 잉곳성장)
높은 기술진입 장벽	낮은 기술진입 장벽
낮은 결함밀도	결함 제어 한계
용이한 Doping 제어	어려운 Doping 제어

05. CAPEX Plan

전방위적으로 확대되는 수요 대응을 위해 생산 능력 증강을 추진 중

진행단계(26.3Q ~)

01

생산성 개선을 통한 물량 확대



- ✓ *안성 본사 공장 기존 생산라인 고도화*
- ✓ *생산 공정운영 및 인력운영 효율화*
- ✓ *재고 선행 생산을 통한 CAPA 운영 효율화*

진행단계(26.3Q ~ 27.2Q)

02

안성 본사 공장 증설



- ✓ *안성 본사 공장 레이아웃 재배치*
- ✓ *핵심 공정 설비 추가 도입*
- ✓ *고객수요의 가시화에 따른 신속한 증설 실행*

계획수립 단계

03

안성테크노밸리 신공장 신설



- ✓ *근거리 신규 생산거점 확보*
- ✓ *현 공장 대비 약 1.5배 부지규모*
- ✓ *고객의 공급확대 요구에 대한 적극적 대응*

04.

Business Performance

01. 실적 Review

Solid-SiC 수요 확대에 따른 실적 성장 지속, 하반기 성장 모멘텀 강화

요약 손익계산서(분기)

(단위 : 억 원)

구분	2026.3Q	2026.2Q	2025.3Q	QoQ	YoY
매출액	1,101.0	948.7	792.4	16.1%	38.9%
매출원가	720.2	612.4	503.4	17.6%	43.1%
매출원가율	65.4%	64.5%	63.5%	0.9%p	1.9%p
매출총이익	380.9	336.4	289.0	13.2%	31.8%
매출총이익율	34.6%	35.5%	36.5%	-0.9%p	-1.9%p
판관비	78.7	67.9	65.3	15.9%	20.6%
판관비율	7.1%	7.2%	8.2%	0.0%p	-1.1%p
영업이익	302.2	268.5	223.8	12.5%	35.0%
영업이익율	27.4%	28.3%	28.2%	-0.9%p	-0.8%p
당기순이익	230.1	236.5	171.4	-2.7%	34.2%
당기순이익율	20.9%	24.9%	21.6%	-4.0%p	-0.7%p

실적 Highlight

01 ***매출액 실적: 외형성장 지속**(YoY +38.9%)*

- *NAND Flash Migration 투자 효과(9세대 V-NAND)*
- *DRAM 신규 라인 증설투자 효과(D1b, D1c Node)*

02 ***영업이익 실적: 이익성장 지속**(YoY +35.0%)*

- *매출액 성장에 따른 이익규모 성장 지속*
- *원화 강세에 의한 외화매출 감소효과(OPM 하락요인)*
- *매출 Prodouct Mix 개선효과(OPM 방어 요인)*

03 ***향후 실적변동 예상요인**(4Q~)*

- *9세대 V-NAND 양산 가동효과 기대*
- *중국 Major NAND 제조사의 증설투자 효과 기대*
- *10세대 V-NAND Migration 투자 수요 기대*

02. 요약 재무제표

견조한 수익성과 안정적인 재무구조를 기반으로 지속 성장 기반 강화

요약 손익계산서(연간누적)

(단위 : 억 원)

구분	2026.3Q	2025Y	2024Y
매출액	**3,003.7**	3,013.3	2,757.2
매출원가	1,930.1	1,915.7	1,715.9
매출원가율	64.3%	63.6%	62.2%
매출총이익	**1,073.6**	1,097.6	1,041.4
매출총이익율	35.7%	36.4%	37.8%
판관비	217.4	258.7	233.9
판관비율	7.2%	8.6%	8.5%
영업이익	**856.2**	838.9	807.5
영업이익율	28.5%	27.8%	29.3%
당기순이익	**717.7**	699.0	719.9
당기순이익율	23.9%	23.2%	26.1%

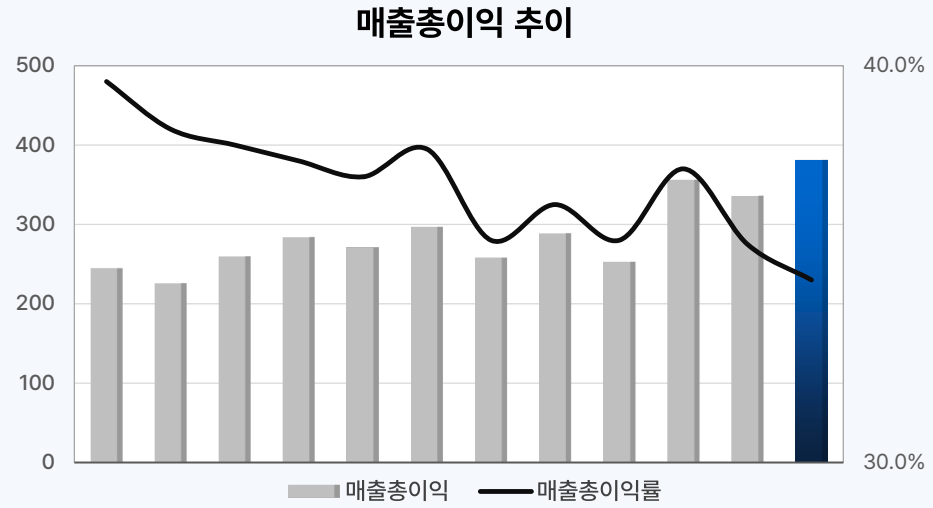
요약 재무상태표

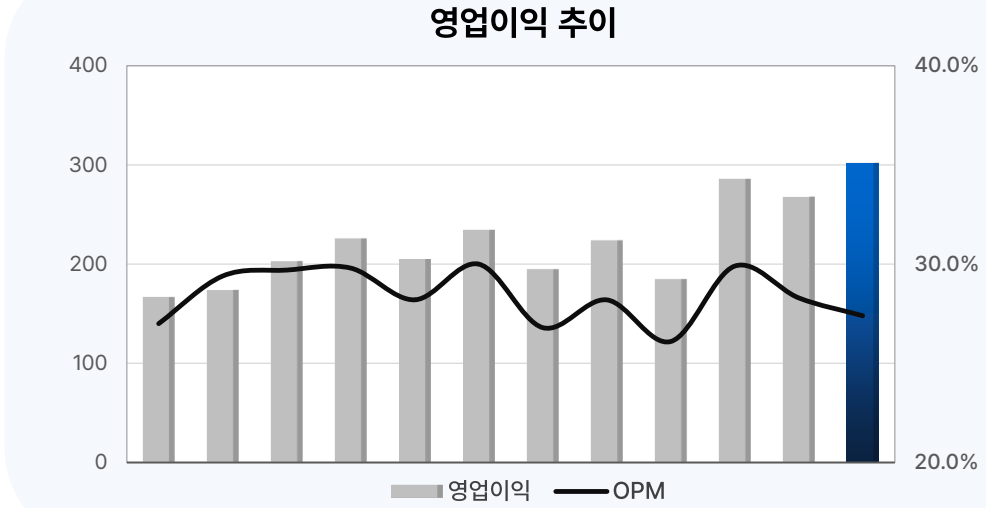
(단위 : 억 원)

구분	2026.3Q	2025Y	2024Y
자산	**6,289.7**	5,676.2	5,635.2
유동자산	4,785.3	4,155.9	4,057.6
· 당좌자산	3,919.3	3,304.5	3,369.4
· 재고자산	866.0	851.4	688.2
비유동자산	1,504.4	1,520.2	1,577.6
부채	**546.5**	483.1	472.6
유동부채	506.1	448.6	445.7
비유동부채	40.3	34.6	26.9
자본	**5,743.3**	5,193.0	5,162.5
자본금	58.4	58.4	58.4
이익잉여금	5,633.7	5,075.9	5,041.5

03. 분기 손익지표

견조한 수익성을 기반으로 외형성장을 통한 이익 규모 확대





구분(단위: 억원)	2023.4Q	2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q	2025.1Q	2025.2Q	2025.3Q	2025.4Q	2026.1Q	**2026.2Q**	**2026.3Q**
매출총이익율	39.6%	38.4%	38.0%	37.6%	37.2%	37.9%	35.6%	36.5%	35.6%	37.4%	35.5%	**34.6%**
매출총이익	245	226	260	284	271	297	258	289	253	356	336	**381**
영업이익률	27.0%	29.4%	29.7%	29.8%	28.2%	30.0%	26.8%	28.2%	26.1%	29.9%	28.3%	**27.4%**
영업이익	167	174	203	226	205	235	195	224	185	286	268	**302**

05.

Appendix

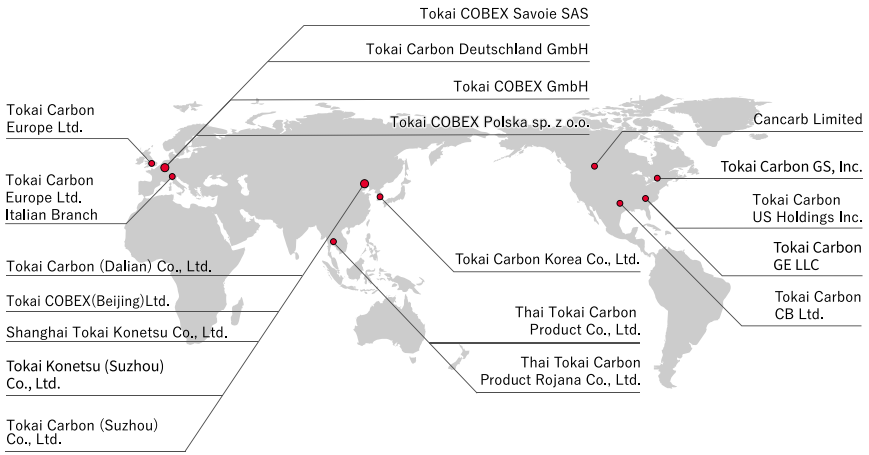
주요 주주정보

1996년 한·일간 Joint Venture로 설립, 2018년 일본의 Tokai Carbon Group 자회사 편입

Tokai Carbon Co.,Ltd.(Leading Shareholder)

- Shareholding : 52.6%

- Establishment : 1918.04.08
- Location : 일본, 도쿄
- Subsidiaries : TCK(Korea), TCU(U.S.A), TCE(Europe), etc.
- Main Biz Division : Fine Carbon, Electrodes, Carbon Black, Friction Materials, Anode Materials, etc.



KC Co.,Ltd.(Second-largest shareholder)

- Shareholding : 6.9%

- Establishment : 1987.02.16
- Location : 한국, 안성
- Subsidiaries : KC Tech, KC EnC, KC Innovation, KC Industrial, etc.
- Main Products : Chemical Mechanical Polishing(CMP)
  Wet Cleaning System, Specialty Gas Supply System
  Central Chemical Supply System(CCSS)



TOKAI CARBON KOREA